

PCT/JP03/16115

16.12.03

日本特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE

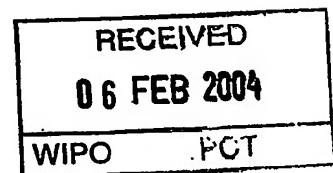
別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日  
Date of Application: 2002年12月16日

出願番号  
Application Number: 特願2002-364131  
[ST. 10/C]: [JP2002-364131]

出願人  
Applicant(s): 浜松ホトニクス株式会社

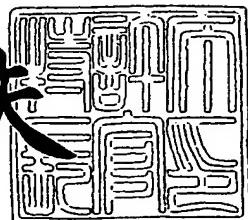


PRIORITY DOCUMENT  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH  
RULE 17.1(a) OR (b)

2004年 1月22日

特許長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

今井康夫



出証番号 出証特2003-3112449

【書類名】 特許願  
【整理番号】 2002-0802  
【提出日】 平成14年12月16日  
【あて先】 特許庁長官殿  
【国際特許分類】 H04N 5/335  
【発明者】  
【住所又は居所】 静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松ホトニクス  
株式会社内  
【氏名】 鈴木 保博  
【発明者】  
【住所又は居所】 静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松ホトニクス  
株式会社内  
【氏名】 水野 誠一郎  
【特許出願人】  
【識別番号】 000236436  
【氏名又は名称】 浜松ホトニクス株式会社  
【代理人】  
【識別番号】 100088155  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 長谷川 芳樹  
【選任した代理人】  
【識別番号】 100089978  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 塩田 辰也  
【選任した代理人】  
【識別番号】 100092657  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 寺崎 史朗

**【選任した代理人】**

【識別番号】 100110582

**【弁理士】**

【氏名又は名称】 柴田 昌聰

**【手数料の表示】**

【予納台帳番号】 014708

【納付金額】 21,000円

**【提出物件の目録】**

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【フルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光検出装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 入射光強度に応じた量の電荷を各々発生する( $K \times M \times N$ )個のフォトダイオード $P D_{k,m,n}$ と(ただし、Kは2以上の整数、kは1以上K以下の各整数、Mは1以上の整数、mは1以上M以下の各整数、Nは2以上の整数、nは1以上N以下の各整数)、

前記( $K \times M \times N$ )個のフォトダイオード $P D_{k,m,n}$ のうちK個のフォトダイオード $P D_{k,m,n}$ ( $k = 1 \sim K$ )に対応して1つずつ設けられ、これらK個のフォトダイオード $P D_{k,m,n}$ ( $k = 1 \sim K$ )それぞれで発生した電荷を順次に入力して蓄積し、この蓄積した電荷の量に応じた電圧値を出力する( $M \times N$ )個の積分回路と、

前記( $M \times N$ )個の積分回路それぞれに対応して1つずつ設けられ、各々対応する積分回路から出力された電圧値に応じたデジタル値を出力するA/D変換回路と、

を備えることを特徴とする光検出装置。

【請求項2】 前記積分回路と前記A/D変換回路との間に設けられ、前記積分回路から出力された電圧値を入力し、この電圧値の一定時間の変化分を表す電圧値を出力するCDS回路を更に備えることを特徴とする請求項1記載の光検出装置。

【請求項3】 前記( $K \times M \times N$ )個のフォトダイオード $P D_{k,m,n}$ がM行( $K \times N$ )列に2次元状( $M = 2$ のとき)または1次元状( $M = 1$ のとき)に配列されており、フォトダイオード $P D_{k,m,n}$ が第m行第( $n + (k - 1)N$ )列の位置に配置されている、ことを特徴とする請求項1記載の光検出装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、配列された複数のフォトダイオードを含む光検出装置に関するものである。

**【0002】****【従来の技術】**

光検出装置は、2次元状または1次元状に配列された複数のフォトダイオードと、アンプおよび積分容量素子を含む積分回路とを備えた装置であり、また、さらにA/D変換回路などをも備える場合がある（例えば特許文献1を参照）。この光検出装置では、各フォトダイオードへの入射光の強度に応じた量の電荷が該フォトダイオードから出力され、その電荷が積分容量素子に蓄積され、その蓄積された電荷の量に応じた電圧値が積分回路から出力される。そして、積分回路から出力された電圧値はA/D変換回路によりデジタル値に変換される。複数のフォトダイオードそれぞれで発生した電荷の量に応じてA/D変換回路から出力されるデジタル値に基づいて、複数のフォトダイオードが配列された光検出面へ入射する光が検出される。

**【0003】****【特許文献1】**

特開平9-270960号公報

**【0004】****【発明が解決しようとする課題】**

しかしながら、このような光検出装置において高速に光検出する際には、A/D変換回路の処理速度を高速にすることが必要であるが、A/D変換回路を高速動作させてA/D変換誤差を低減しようとすると、A/D変換回路の消費電力が大きくなる。多数のA/D変換回路を集積化する場合には、A/D変換回路の消費電力が大きいほど、発熱の問題が生じる。したがって、A/D変換回路を高速動作させるにも限界がある。

**【0005】**

本発明は、上記問題点を解消する為になされたものであり、A/D変換回路を含み高速動作が可能な光検出装置を提供することを目的とする。

**【0006】****【課題を解決するための手段】**

本発明に係る光検出装置は、(1) 入射光強度に応じた量の電荷を各自発生する

( $K \times M \times N$ )個のフォトダイオード  $P D_{k,m,n}$  と (ただし、 $K$ は2以上の整数、 $k$ は1以上 $K$ 以下の各整数、 $M$ は1以上の整数、 $m$ は1以上 $M$ 以下の各整数、 $N$ は2以上の整数、 $n$ は1以上 $N$ 以下の各整数)、(2) ( $K \times M \times N$ )個のフォトダイオード  $P D_{k,m,n}$  のうち $K$ 個のフォトダイオード  $P D_{k,m,n}$  ( $k = 1 \sim K$ ) に対応して1つずつ設けられ、これら $K$ 個のフォトダイオード  $P D_{k,m,n}$  ( $k = 1 \sim K$ ) それぞれで発生した電荷を順次に入力して蓄積し、この蓄積した電荷の量に応じた電圧値を出力する( $M \times N$ )個の積分回路と、(3) ( $M \times N$ )個の積分回路それぞれに対応して1つずつ設けられ、各々対応する積分回路から出力された電圧値に応じたデジタル値を出力するA/D変換回路と、を備えることを特徴とする。

### 【0007】

本発明に係る光検出装置では、各 $m$ 値および各 $n$ 値について、 $K$ 個のフォトダイオード  $P D_{k,m,n}$  ( $k = 1 \sim K$ ) それぞれにおいて光入射に応じて発生した電荷は、順次に、1個の積分回路に入力して蓄積され、この蓄積された電荷の量に応じた電圧値が積分回路から出力される。そして、積分回路から出力された電圧値に応じたデジタル値がA/D変換回路から出力される。したがって、この光検出装置は高速動作が可能である。

### 【0008】

本発明に係る光検出装置は、積分回路とA/D変換回路との間に設けられ、積分回路から出力された電圧値を入力し、この電圧値の一定時間の変化分を表す電圧値を出力するCDS回路を更に備えるのが好適である。この場合には、積分回路から出力された電圧値はCDS回路に入力して、この電圧値の一定時間の変化分を表す電圧値がCDS回路から出力されるので、積分回路のアンプのオフセットばらつきがCDS回路により除去され得る。

### 【0009】

本発明に係る光検出装置は、( $K \times M \times N$ )個のフォトダイオード  $P D_{k,m,n}$  が $M$ 行( $K \times N$ )列に2次元状 ( $M = 2$ のとき) または1次元状 ( $M = 1$ のとき) に配列されており、フォトダイオード  $P D_{k,m,n}$  が第 $m$ 行第( $n + (k - 1)N$ )列の位置に配置されているのが好適である。この場合には、フォトダイオードについて

ての処理（電荷蓄積およびA/D変換の他、必要に応じてCDS）は、各行について列の並び順になされ得る。

### 【0010】

#### 【発明の実施の形態】

以下、添付図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。なお、図面の説明において同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。

### 【0011】

図1は、本実施形態に係る光検出装置1の全体構成図である。図2は、本実施形態に係る光検出装置1の一部構成図である。図1で示された光検出部10の詳細が図2に示されている。

### 【0012】

これらの図に示される光検出装置1は、光検出部10、(M×N)個の積分回路 $20_{1,1} \sim 20_{M,N}$ 、(M×N)個のCDS回路 $30_{1,1} \sim 30_{M,N}$ 、(M×N)個のフィルタ回路 $40_{1,1} \sim 40_{M,N}$ 、(M×N)個のA/D変換回路 $50_{1,1} \sim 50_{M,N}$ 、および制御回路60を備える。また、光検出部10は、(K×M×N)個のフォトダイオード $PD_{1,1,1} \sim PD_{K,M,N}$ および、(K×M×N)個のスイッチ $SW_{1,1,1} \sim SW_{K,M,N}$ を有する。ここで、Kは2以上の整数であり、Mは1以上の整数であり、Nは2以上の整数である。また、以下に現れるk, m, nについては、kは1以上K以下の各整数であり、mは1以上M以下の各整数であり、nは1以上N以下の各整数である。なお、図1および図2では、Kを2とし、MおよびNを4としている。

### 【0013】

フォトダイオード $PD_{k,m,n}$ は、入射光強度に応じた量の電荷を発生して接合容量部に蓄積するものである。これら(K×M×N)個のフォトダイオード $PD_{k,m,n}$ は、光検出部10において、M行(K×N)列に2次元状(M=2のとき)または1次元状(M=1のとき)に等間隔に配列されている。フォトダイオード $PD_{k,m,n}$ は第m行第(n+(k-1)N)列の位置に配置されている。スイッチ $SW_{k,m,n}$ は、フォトダイオード $PD_{k,m,n}$ に対して1対1に対応して、該フォトダイオード $PD_{k,m,n}$ と信号線 $SL_{m,n}$ との間に設けられている。K個のフォトダイオ

ード  $P D_{k,m,n}$  ( $k = 1 \sim K$ ) それぞれは、対応するスイッチ  $S W_{k,m,n}$  を介して、信号線  $S L_{m,n}$  と接続されている。この信号線  $S L_{m,n}$  は、積分回路  $20_{m,n}$  の入力端に接続されている。また、M個のスイッチ  $S W_{k,m,n}$  ( $m = 1 \sim M$ ) は、制御回路 60 から制御線  $C L_{k,n}$  に出力された制御信号により一括して開閉が制御される。

#### 【0014】

積分回路  $20_{m,n}$  は、K個のフォトダイオード  $P D_{k,m,n}$  ( $k = 1 \sim K$ ) に対応して1つずつ設けられており、これらK個のフォトダイオード  $P D_{k,m,n}$  ( $k = 1 \sim K$ ) それぞれで発生した電荷がスイッチ  $S W_{k,m,n}$  および信号線  $S L_{m,n}$  を経て順次に到達した電荷を入力して蓄積し、この蓄積した電荷の量に応じた電圧値を出力する。CDS (Correlated Double Sampling、相関二重サンプリング) 回路  $30_{m,n}$  は、積分回路  $20_{m,n}$  から出力された電圧値を入力し、この電圧値の一定時間の変化分を表す電圧値を出力する。

#### 【0015】

フィルタ回路  $40_{m,n}$  は、CDS回路  $30_{m,n}$  から出力された電圧値を入力して、この電圧値に含まれる熱雑音成分を低減して、その熱雑音成分低減後の電圧値を出力する。このフィルタ回路  $40_{m,n}$  は、熱雑音成分を低減し得るフィルタ特性を有するローパスフィルタであるのが好適である。A/D変換回路  $50_{m,n}$  は、フィルタ回路  $40_{m,n}$  から出力された電圧値を入力し、この電圧値をA/D変換して、この電圧値（アナログ値）に応じたデジタル値を出力する。

#### 【0016】

制御回路 60 は、( $K \times M \times N$ ) 個のスイッチ  $S W_{1,1,1} \sim S W_{K,M,N}$  それぞれの開閉を制御する為の制御信号を制御線  $C L_{k,n}$  に出力する。また、制御回路 60 は、積分回路  $20_{m,n}$ 、CDS回路  $30_{m,n}$  およびA/D変換回路  $50_{m,n}$  それぞれの動作をも制御する。

#### 【0017】

図3は、本実施形態に係る光検出装置1の回路図である。この図では、簡略化の為に、フォトダイオード  $P D_{k,m,n}$ 、スイッチ  $S W_{k,m,n}$ 、積分回路  $20_{m,n}$ 、CDS回路  $30_{m,n}$ 、フィルタ回路  $40_{m,n}$  およびA/D変換回路  $50_{m,n}$  が1組

のみ示されている。

#### 【0018】

積分回路 $20_{m,n}$ は、アンプA<sub>20</sub>、積分容量素子C<sub>20</sub>およびスイッチSW<sub>20</sub>を有している。アンプA<sub>20</sub>の入力端子は信号線S<sub>L<sub>m,n</sub></sub>に接続されている。アンプA<sub>20</sub>の入出力端子間に積分容量素子C<sub>20</sub>およびスイッチSW<sub>20</sub>が並列的に設けられている。スイッチSW<sub>20</sub>は制御部60により制御されて開閉する。スイッチSW<sub>20</sub>が閉じているとき、積分容量素子C<sub>20</sub>は放電されて、積分回路 $20_{m,n}$ から出力される電圧値は初期化される。一方、スイッチSW<sub>20</sub>が開いているとき、信号線S<sub>L<sub>m,n</sub></sub>を経て到達した電荷が積分容量素子C<sub>20</sub>に蓄積され、この積分容量素子C<sub>20</sub>に蓄積されている電荷の量に応じた電圧値が積分回路 $20_{m,n}$ から出力される。

#### 【0019】

CDS回路 $30_{m,n}$ は、アンプA<sub>30</sub>、積分容量素子C<sub>31</sub>、結合容量素子C<sub>32</sub>およびスイッチSW<sub>30</sub>を有している。アンプA<sub>30</sub>の入力端子は、結合容量素子C<sub>32</sub>を介して、積分回路 $20_{m,n}$ のアンプA<sub>20</sub>の出力端子に接続されている。アンプA<sub>30</sub>の入出力端子間に積分容量素子C<sub>31</sub>およびスイッチSW<sub>30</sub>が並列的に設けられている。スイッチSW<sub>30</sub>は制御部60により制御されて開閉する。スイッチSW<sub>30</sub>が閉じているとき、積分容量素子C<sub>31</sub>は放電されて、CDS回路 $30_{m,n}$ から出力される電圧値は初期化される。一方、スイッチSW<sub>30</sub>が開いた時刻t<sub>0</sub>より以降、積分回路 $20_{m,n}$ から出力された電圧値の変動分に応じた電荷が積分容量素子C<sub>31</sub>に蓄積され、この積分容量素子C<sub>31</sub>に蓄積されている電荷の量に応じた電圧値がCDS回路 $30_{m,n}$ から出力される。

#### 【0020】

フィルタ回路 $40_{m,n}$ は、抵抗素子R<sub>40</sub>および容量素子C<sub>40</sub>を有している。抵抗素子R<sub>40</sub>は、フィルタ回路 $40_{m,n}$ の入力端と出力端との間に設けられており、その出力端は、容量素子C<sub>40</sub>を介して接地電位と接続されている。このフィルタ回路 $40_{m,n}$ はローパスフィルタとして作用し、そのフィルタ特性におけるカットオフ周波数は、抵抗素子R<sub>40</sub>の抵抗値および容量素子C<sub>40</sub>の容量値に応じたものである。

## 【0021】

図3に示された回路図において、各素子の特性値の一例は以下のとおりである。フォトダイオードPD<sub>m,n</sub>の接合容量値C<sub>d</sub>と信号線SL<sub>m,n</sub>の寄生容量値との和は220pFであり、信号線SL<sub>m,n</sub>の抵抗値は1kΩである。積分回路20<sub>m,n</sub>の積分容量素子C<sub>20</sub>の容量値C<sub>f</sub>は1.25pFであり、積分回路20<sub>m,n</sub>のアンプA<sub>20</sub>の周波数帯域Bは1MHzである。アンプA<sub>20</sub>の入力トランジスタ・コンダクタンスG<sub>m</sub>は10mSである。また、温度Tは27℃である。このとき、積分回路20<sub>m,n</sub>のアンプA<sub>20</sub>で生じる熱雑音V<sub>n</sub>は1210μV<sub>rms</sub>である。そして、フィルタ回路40<sub>m,n</sub>の容量素子C<sub>40</sub>の容量値を100pFとし、フィルタ回路40<sub>m,n</sub>の抵抗素子R<sub>40</sub>の抵抗値を20kΩとすると、フィルタ回路40<sub>m,n</sub>のフィルタ特性におけるカットオフ周波数は0.08MHzであり、フィルタ回路40<sub>m,n</sub>から出力される電圧値に含まれる熱雑音成分は724μV<sub>rms</sub>まで低減される。

## 【0022】

次に、本実施形態に係る光検出装置1の動作について説明する。本実施形態に係る光検出装置1は、制御部60による制御の下に、以下のように動作する。図4は、本実施形態に係る光検出装置1の動作を説明するタイミングチャートである。この光検出装置1は、第1行～第M行が並列動作する。

## 【0023】

この図には、上から順に、スイッチSW<sub>1,m,1</sub>の開閉、スイッチSW<sub>1,m,2</sub>の開閉、スイッチSW<sub>1,m,3</sub>の開閉、スイッチSW<sub>1,m,4</sub>の開閉、スイッチSW<sub>2,m,1</sub>の開閉、スイッチSW<sub>2,m,2</sub>の開閉、スイッチSW<sub>2,m,3</sub>の開閉、および、スイッチSW<sub>2,m,4</sub>の開閉、が示されている。さらに続いて、積分回路20<sub>m,1</sub>の出力電圧値、積分回路20<sub>m,2</sub>の出力電圧値、積分回路20<sub>m,3</sub>の出力電圧値、積分回路20<sub>m,4</sub>の出力電圧値、フィルタ回路40<sub>m,1</sub>の出力電圧値、フィルタ回路40<sub>m,2</sub>の出力電圧値、フィルタ回路40<sub>m,3</sub>の出力電圧値、フィルタ回路40<sub>m,4</sub>の出力電圧値、A/D変換回路50<sub>m,1</sub>の出力デジタル値、A/D変換回路50<sub>m,2</sub>の出力デジタル値、A/D変換回路50<sub>m,3</sub>の出力デジタル値、および、A/D変換回路50<sub>m,4</sub>の出力デジタル値、が示されている。

## 【0024】

また、この図に示されるように、光検出装置1の動作は、循環する8つの期間 $T_{1,1}$ 、 $T_{1,2}$ 、 $T_{1,3}$ 、 $T_{1,4}$ 、 $T_{2,1}$ 、 $T_{2,2}$ 、 $T_{2,3}$ および $T_{2,4}$ に区分される。これらの各期間 $T_{k,n}$ の時間 $T$ は一定である。スイッチ $SW_{1,m,1}$ は期間 $T_{1,1}$ 内に閉じ、スイッチ $SW_{1,m,2}$ は期間 $T_{1,2}$ 内に閉じ、スイッチ $SW_{1,m,3}$ は期間 $T_{1,3}$ 内に閉じ、スイッチ $SW_{1,m,4}$ は期間 $T_{1,4}$ 内に閉じ、スイッチ $SW_{2,m,1}$ は期間 $T_{2,1}$ 内に閉じ、スイッチ $SW_{2,m,2}$ は期間 $T_{2,2}$ 内に閉じ、スイッチ $SW_{2,m,3}$ は期間 $T_{2,3}$ 内に閉じ、スイッチ $SW_{2,m,4}$ は期間 $T_{2,4}$ 内に閉じ、以降、このようなスイッチの開閉が繰り返される。

## 【0025】

スイッチ $SW_{1,m,1}$ は期間 $T_{1,1}$ 内に閉じる。また、この期間 $T_{1,1}$ 前に、積分回路 $20_{m,1}$ のスイッチ $SW_{20}$ は一旦閉じた後に開き、積分回路 $20_{m,1}$ の出力電圧値は初期化されている。スイッチ $SW_{1,m,1}$ が閉じると、それまでフォトダイオード $PD_{1,m,1}$ で発生して接合容量部に蓄積されていた電荷は、スイッチ $SW_{1,m,1}$ および信号線 $SL_{m,1}$ を経て積分回路 $20_{m,1}$ に入力し、この積分回路 $20_{m,1}$ の積分容量素子 $C_{20}$ に蓄積され、その蓄積された電荷の量に応じた電圧値が積分回路 $20_{m,1}$ から出力される。積分回路 $20_{m,1}$ の出力電圧値は期間 $T_{1,1}$ 後も期間 $T_{1,3}$ まで保持され、期間 $T_{1,4}$ になって、積分回路 $20_{m,1}$ のスイッチ $SW_{20}$ が閉じると、積分回路 $20_{m,1}$ の出力電圧値が初期化される。

## 【0026】

積分回路 $20_{m,1}$ の出力電圧値はCDS回路 $30_{m,1}$ に入力する。このCDS回路 $30_{m,1}$ からは、期間 $T_{1,1}$ から期間 $T_{1,2}$ までのうちの一定時間における積分回路 $20_{m,1}$ の出力電圧値の変化分に応じた電圧値が出力される。CDS回路 $30_{m,1}$ の出力電圧値は、フィルタ回路 $40_{m,1}$ に入力して熱雑音成分が低減される。しかし、フィルタ回路 $40_{m,1}$ のフィルタ特性に因り、フィルタ回路 $40_{m,1}$ の出力電圧波形は、CDS回路 $30_{m,1}$ の出力電圧波形と比べて鈍ったものとなる。

## 【0027】

フィルタ回路 $40_{m,1}$ の出力電圧値は、その値が安定した時点でA/D変換回

路 $50_{m,1}$ によりA/D変換されて、期間 $T_{1,3}$ にA/D変換回路 $50_{m,1}$ からデジタル値が outputされる。ここで、期間 $T_{1,3}$ にA/D変換回路 $50_{m,1}$ から出力されるデジタル値は、期間 $T_{1,1}$ にフォトダイオード $PD_{1,m,1}$ の接合容量部から積分回路 $20_{m,1}$ の積分容量素子 $C_{20}$ に移動した電荷の量に応じたもの、すなわち、フォトダイオード $PD_{1,m,1}$ への光入射の強度に応じたものである。

### 【0028】

また、スイッチ $SW_{2,m,1}$ は期間 $T_{2,1}$ 内に閉じる。また、この期間 $T_{2,1}$ 前に、積分回路 $20_{m,1}$ のスイッチ $SW_{20}$ は一旦閉じた後に開き、積分回路 $20_{m,1}$ の出力電圧値は初期化されている。スイッチ $SW_{2,m,1}$ が閉じると、それまでフォトダイオード $PD_{2,m,1}$ で発生して接合容量部に蓄積されていた電荷は、スイッチ $SW_{2,m,1}$ および信号線 $SL_{m,1}$ を経て積分回路 $20_{m,1}$ に入力し、この積分回路 $20_{m,1}$ の積分容量素子 $C_{20}$ に蓄積され、その蓄積された電荷の量に応じた電圧値が積分回路 $20_{m,1}$ から出力される。積分回路 $20_{m,1}$ の出力電圧値は期間 $T_{2,1}$ 後も期間 $T_{2,3}$ まで保持され、期間 $T_{2,4}$ になって、積分回路 $20_{m,1}$ のスイッチ $SW_{20}$ が閉じると、積分回路 $20_{m,1}$ の出力電圧値が初期化される。

### 【0029】

積分回路 $20_{m,1}$ の出力電圧値はCDS回路 $30_{m,1}$ に入力する。このCDS回路 $30_{m,1}$ からは、期間 $T_{2,1}$ から期間 $T_{2,2}$ までのうちの一定時間における積分回路 $20_{m,1}$ の出力電圧値の変化分に応じた電圧値がoutputされる。CDS回路 $30_{m,1}$ の出力電圧値は、フィルタ回路 $40_{m,1}$ に入力して熱雑音成分が低減される。しかし、フィルタ回路 $40_{m,1}$ のフィルタ特性に因り、フィルタ回路 $40_{m,1}$ の出力電圧波形は、CDS回路 $30_{m,1}$ の出力電圧波形と比べて鈍ったものとなる。

### 【0030】

フィルタ回路 $40_{m,1}$ の出力電圧値は、その値が安定した時点でA/D変換回路 $50_{m,1}$ によりA/D変換されて、期間 $T_{2,3}$ にA/D変換回路 $50_{m,1}$ からデジタル値が outputされる。ここで、期間 $T_{2,3}$ にA/D変換回路 $50_{m,1}$ から出力されるデジタル値は、期間 $T_{2,1}$ にフォトダイオード $PD_{2,m,1}$ の接合容量部から積分回路 $20_{m,1}$ の積分容量素子 $C_{20}$ に移動した電荷の量に応じたもの、すなわち

、フォトダイオード  $P D_{2,m,1}$ への光入射の強度に応じたものである。

#### 【0031】

以上では、スイッチ  $S W_{1,m,1}$ 、スイッチ  $S W_{2,m,1}$ 、積分回路  $20_{m,1}$ 、CD S回路  $30_{m,1}$ 、フィルタ回路  $40_{m,1}$ およびA/D変換回路  $50_{m,1}$ について、すなわち、 $n$ が1の場合について、動作を説明した。 $n$ が2～4の場合も、動作タイミングがシフトするものの同様である。

#### 【0032】

したがって、フォトダイオード  $P D_{1,m,1}$ への光入射の強度に応じたデジタル値が期間  $T_{1,3}$ に出力され、フォトダイオード  $P D_{1,m,2}$ への光入射の強度に応じたデジタル値が期間  $T_{1,4}$ に出力され、フォトダイオード  $P D_{1,m,3}$ への光入射の強度に応じたデジタル値が期間  $T_{2,1}$ に出力され、フォトダイオード  $P D_{1,m,4}$ への光入射の強度に応じたデジタル値が期間  $T_{2,2}$ に出力され、フォトダイオード  $P D_{2,m,1}$ への光入射の強度に応じたデジタル値が期間  $T_{2,3}$ に出力され、フォトダイオード  $P D_{2,m,2}$ への光入射の強度に応じたデジタル値が期間  $T_{2,4}$ に出力され、フォトダイオード  $P D_{2,m,3}$ への光入射の強度に応じたデジタル値がその後の期間  $T_{1,1}$ に出力され、フォトダイオード  $P D_{2,m,4}$ への光入射の強度に応じたデジタル値が期間  $T_{1,2}$ に出力される。

#### 【0033】

以上のように、本実施形態に係る光検出装置1では、( $K \times M \times N$ )個のフォトダイオード  $P D_{k,m,n}$ が光検出部10においてM行( $K \times N$ )列に配列されていて、各行の( $K \times N$ )個のフォトダイオード  $P D_{k,m,n}$ ( $k = 1 \sim K$ 、 $n = 1 \sim N$ )について順次に時間T毎に処理(電荷蓄積、CDS、フィルタリング、A/D変換)がなされる。一方、積分回路  $20_{m,n}$ における電荷蓄積動作、CDS回路  $30_{m,n}$ におけるCDS動作、フィルタ回路  $40_{m,n}$ におけるフィルタリング動作、および、A/D変換回路  $50_{m,n}$ におけるA/D変換動作それぞれは、時間( $N \times T$ )毎に処理がなされる。

#### 【0034】

本実施形態に係る光検出装置1では、A/D変換回路  $50_{m,n}$ は時間( $N \times T$ )毎に処理をすればよく、A/D変換回路  $50_{m,n}$ に対する高速処理の要求が緩和

されるので、A/D変換回路 $50_{m,n}$ における消費電力の増加が抑制される。

### 【0035】

また、積分回路 $20_{m,n}$ から出力された電圧値に含まれる熱雑音成分がフィルタ回路 $40_{m,n}$ により低減される。また、フィルタ回路 $40_{m,n}$ から出力される電圧値波形は鈍るが、積分回路 $20_{m,n}$ における電荷蓄積からA/D変換回路 $50_{m,n}$ におけるA/D変換に至る迄の動作は時間( $N \times T$ )毎に処理がなされ、フィルタ回路 $40_{m,n}$ から出力される電圧値は、その値が安定した時点でA/D変換回路 $50_{m,n}$ によりA/D変換される。したがって、この光検出装置1は、光検出の高速性を維持したまま、光検出のS/N比が改善され得る。また、積分回路 $20_{m,n}$ に含まれるアンプA<sub>20</sub>の入力トランジスタ・コンダクタンス $G_m$ を大きくしなくとも、光検出のS/N比の改善が図られるので、アンプA<sub>20</sub>の消費電力の増加が抑制され、この点でも、発熱の問題が低減される。

### 【0036】

また、CDS回路 $30_{m,n}$ が設けられていることにより、積分回路 $20_{m,n}$ のアンプA<sub>20</sub>のオフセットばらつきがCDS回路 $30_{m,n}$ により除去されるので、この点でも、光検出のS/N比の改善が図られる。なお、CDS回路 $30_{m,n}$ にもアンプA<sub>30</sub>が含まれているが、このアンプA<sub>30</sub>で生じる熱雑音は、積分回路 $20_{m,n}$ に含まれているアンプA<sub>20</sub>で生じる熱雑音と比べて僅かである。

### 【0037】

さらに、( $K \times M \times N$ )個のフォトダイオード $PD_{k,m,n}$ がM行( $K \times N$ )列に配列されていて、フォトダイオード $PD_{k,m,n}$ が第m行第( $n + (k - 1)N$ )列の位置に配置されており、フォトダイオード $PD_{k,m,n}$ についての処理(電荷蓄積、CDS、フィルタリング、A/D変換)が各行について列の並び順になされるので、光検出装置1により得られた光検出データの記憶や画像処理が容易である。

### 【0038】

#### 【発明の効果】

以上、詳細に説明したとおり、本発明に係る光検出装置では、各m値および各n値について、K個のフォトダイオード $PD_{k,m,n}$  ( $k = 1 \sim K$ ) それぞれにおいて光入射に応じて発生した電荷は、順次に、1個の積分回路に入力して蓄積さ

れ、この蓄積された電荷の量に応じた電圧値が積分回路から出力される。そして、積分回路から出力された電圧値に応じたデジタル値がA／D変換回路から出力される。したがって、この光検出装置は高速動作が可能である。

#### 【図面の簡単な説明】

##### 【図1】

本実施形態に係る光検出装置1の全体構成図である。

##### 【図2】

本実施形態に係る光検出装置1の一部構成図である。

##### 【図3】

本実施形態に係る光検出装置1の回路図である。

##### 【図4】

本実施形態に係る光検出装置1の動作を説明するタイミングチャートである。

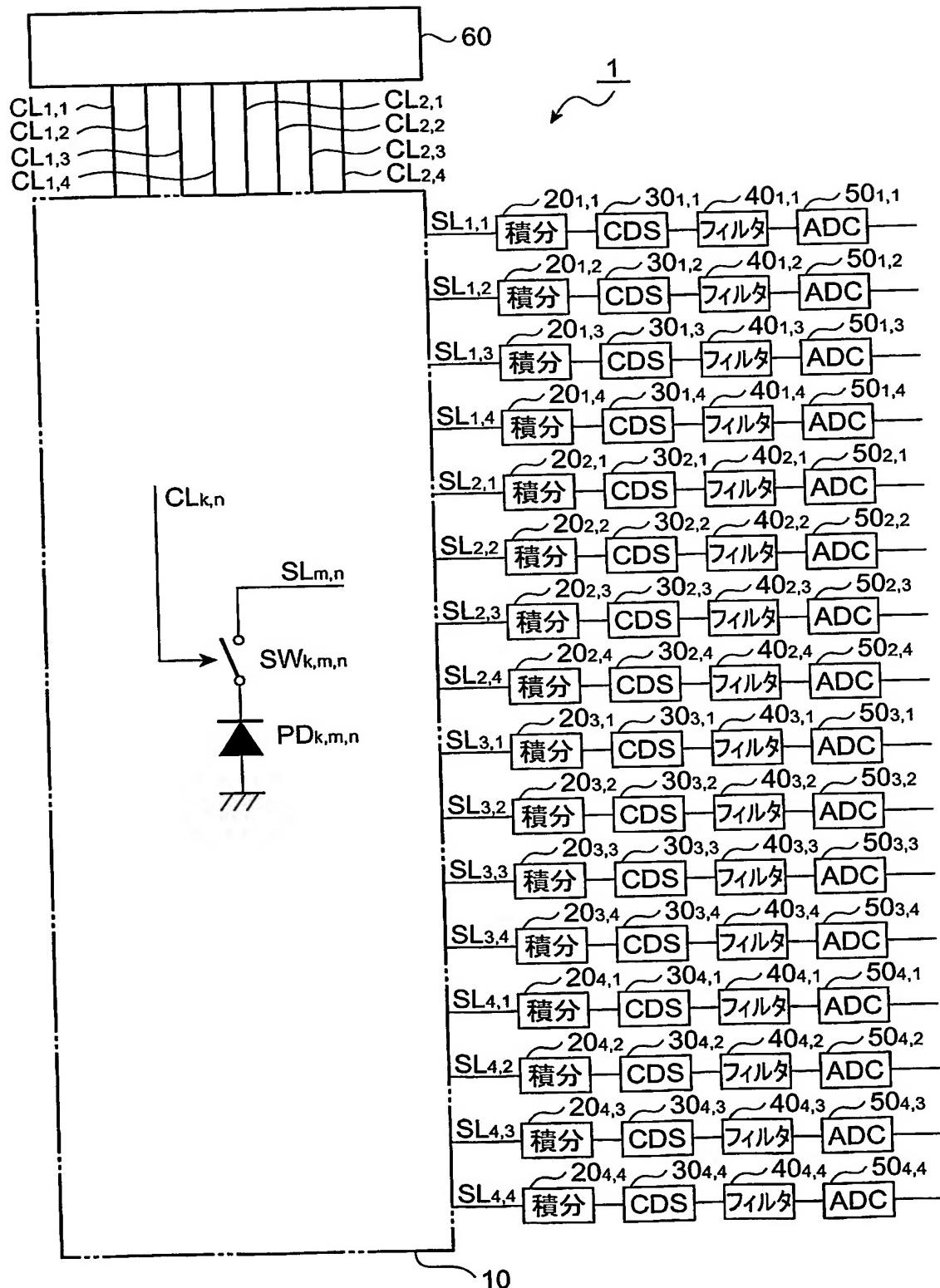
#### 【符号の説明】

1…光検出装置、10…光検出部、20…積分回路、30…CDS回路、40…フィルタ回路、50…A／D変換回路、60…制御回路、A…アンプ、C…容量素子、R…抵抗素子、PD…フォトダイオード、SW…スイッチ、CL…制御線、SL…信号線。

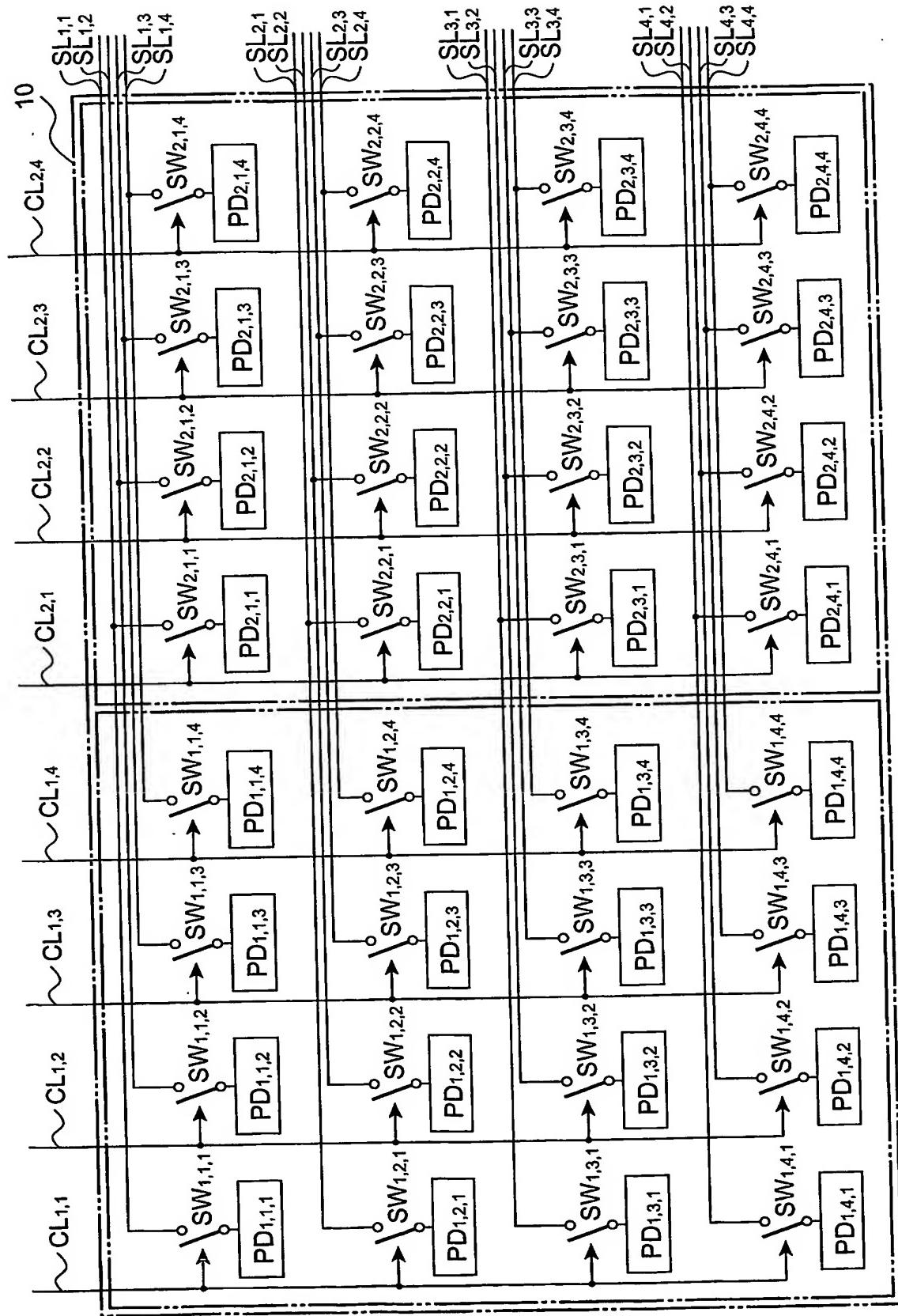
【書類名】

図面

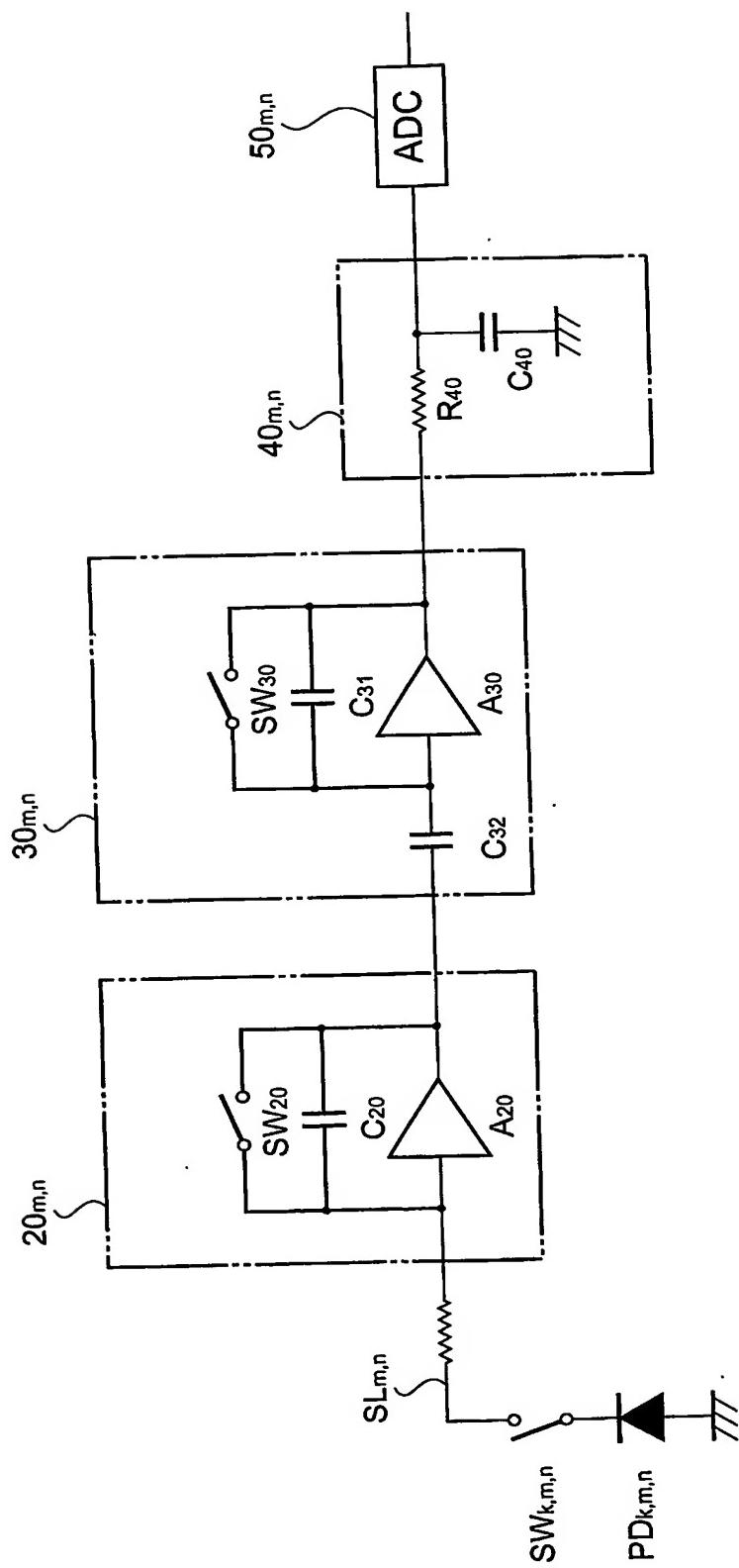
【図 1】



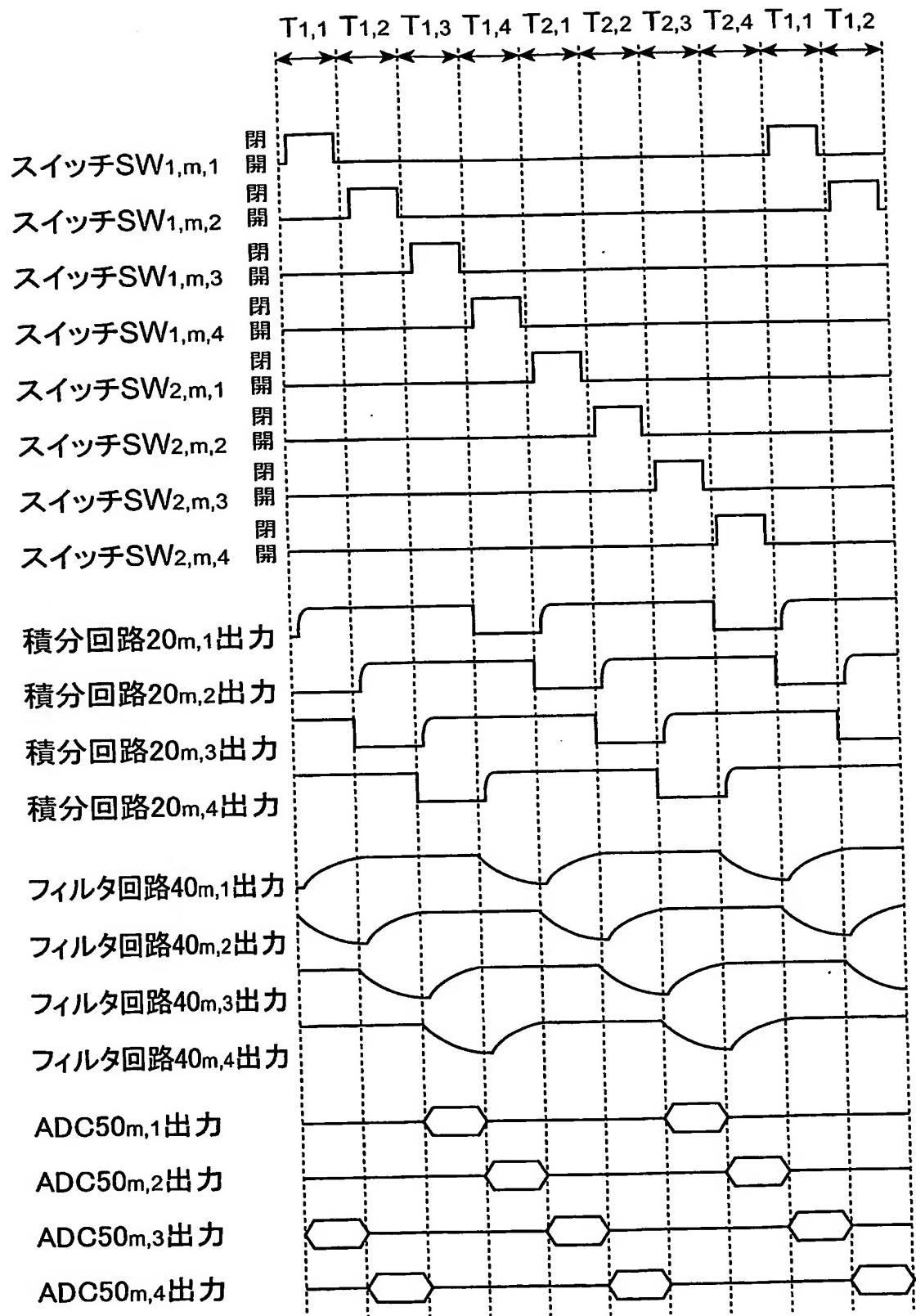
【図2】



【図3】



【図4】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 A/D変換回路を含み高速動作が可能な光検出装置を提供する。

【解決手段】 光検出装置1では、(K×M×N)個のフォトダイオードPD<sub>k,m,n</sub>が光検出部10においてM行(K×N)列に配列されていて、各行の(K×N)個のフォトダイオードPD<sub>k,m,n</sub>(k=1~K, n=1~N)それぞれについて、時間T毎に処理(電荷蓄積、CDS、フィルタリング、A/D変換)がなされる。積分回路20<sub>m,n</sub>における電荷蓄積動作、CDS回路30<sub>m,n</sub>におけるCDS動作、フィルタ回路40<sub>m,n</sub>におけるフィルタリング動作、および、A/D変換回路50<sub>m,n</sub>におけるA/D変換動作それぞれは、時間(N×T)毎に処理がなされる。

【選択図】 図1

特願 2002-364131

出願人履歴情報

識別番号

[000236436]

1. 変更年月日

[変更理由]

住所  
氏名

1990年 8月10日

新規登録

静岡県浜松市市野町1126番地の1  
浜松ホトニクス株式会社